UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos	21/10/2017 22:30 Titulo: Proyecto 1 Mezclador de Audio
sábado, 21 de octubre de 20	017, Ciudad Universitaria, México, DF
	2 de 15

TITULO: Proyecto 1 Mezclador de Audio

OBJETIVO: Diseñar y construir de un mezclador de audio, mediante la teoría vista en clase de amplificadores electrónicos.

ESPECIFICACIONES DEL MEZCLADOR:

La realización del diseño del circuito de mezclado, es la forma como se estudio en clase. Serán cuatro señales a mezclar, señal de micrófono, señal de walkman, señal de cdwalkman, y una señal auxiliar de algún minicomponente, el cual tenga controles individuales y un control maestro. El amplificador operacional LM741, es de propósito general y es el que utilizaremos para nuestro prototipo.

DISEÑO FUENTE DE TENSIÓN:

Para la realización de la fuente de tensión¹, pensamos primero en la potencia que requerimos en nuestra carga, por lo que ésta, estará en función de la potencia máxima que queremos disipar.

Carga: 8[Ω]

 $P=I^2*R$

Si deseamos alimentar un altavoz de 8 $[\Omega]$ y con potencia máxima de 5 [W].

 $5[W] = I^{2*}(8[\Omega])$

$$I = \sqrt{\frac{5[W]}{8[\Omega]}} = 0.7905[A]$$

Esta corriente la podemos obtener con un regulador comercial 7805, el cual entrega corriente de hasta 1.0 [A].

$$P=(1[A])^{2*}[8]=8[W]$$

Por lo que la potencia máxima de la bocina será de 8[w] a $8[\Omega]$

¹ Según la Norma Oficial Mexicana (NOM), las variables eléctricas son Tensión, Corriente y Potencia, mientras que para la Norma Oficial Española, son Voltaje, Amperaje y Wataje, lo cual hace un mal uso del término voltaje para nuestro ambiente profesional.

ESPECIFICACIONES DEL MEZCLADOR:

La realización del diseño del circuito de mezclado, es la forma como se estudio en clase. Serán cuatro señales a mezclar, señal de micrófono, señal de walkman, señal de cdwalkman, y una señal auxiliar de algún minicomponente, el cual tenga controles individuales y un control maestro.

MEDICIONES DE LAS SEÑALES ENTRANTES

WALKMAN: amplitud máxima medida fue de 1.2 [V] de pico, y esto es lógico, debido a que el walkman se alimenta con dos baterías de 1.5 [V]

MICROFONO: debido a que no contábamos con un micrófono, construimos uno con un teléfono viejo, el cual necesitaba polarizarse. La amplitud máxima de la voz fue cercana a 100 [mV] de pico.

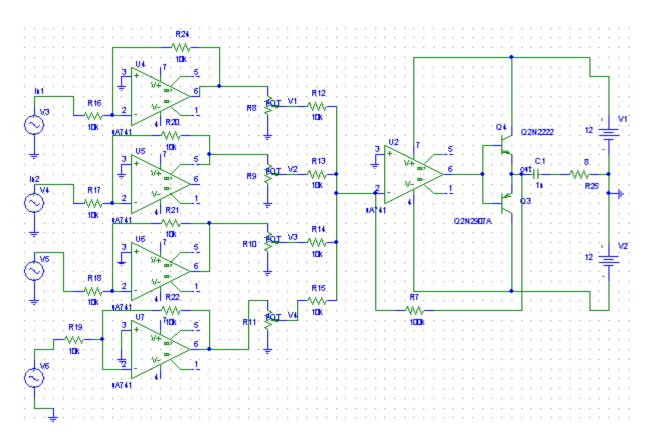
CDWALKMAN: se alimenta con dos bate5rias de 1.5 [V], la amplitud máxima que medimos fue de 1.3 [V] de pico.

SEÑAL AUXILIAR: fue medida en un minicomponente Sony, con una amplitud cercana a 1[V] de pico.

ETAPA DE MEZCLADO:

El circuito es simple, un amplificador sumador visto en clase, pero con controles de amplitud de entrada para cada señal, como los mostrados a continuación:

CIRCUITO MEZCLADOR



En la primera etapa, lo que se trato de hacer fue darle una ganancia adecuada a cada una de las señales para que entraran al mezclador de la misma amplitud, en la entrada del micrófono, colocamos una resistencia de polarización de 10k. Así, mediante el control por los potenciómetros tendríamos un mejor manejo de las señales.

Recordando la expresión que caracteriza a un mezclador, analizada en clase:

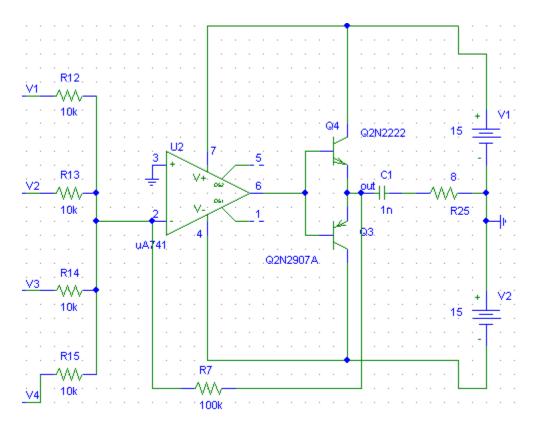
$$Vs = -k1V1 - k2V2 - k3V3 - k4V4$$

Donde las constantes Ki, son la razón de la resistencia de realimentación y la resistencia que entran por la terminar inversora de la señal de entrada Vi.

Conectamos un potenciómetro de 100k en la realimentación para dar un control maestro al circuito, con esto, obtenemos una ganancia adecuada para no saturar al amplificador LM741.

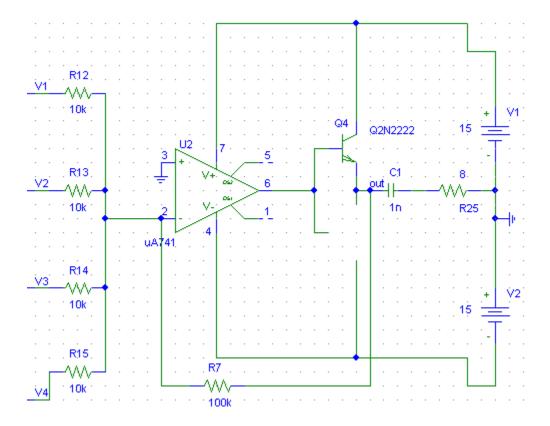
ETAPA DE POTENCIA:

La etapa de potencia es una Push pull realimentada (transistores complementarios) la cual se presenta a continuación.



Esta etapa presenta una interesante teoría ya que las uniones base-emisor de cada transistor no necesitan polarización, debido a la ganancia de lazo abierto infinita del amplificador operacional.

Cuando la señal es positiva, polariza al transistor NPN



Para el análisis en AC, las fuentes de DC quedan cortocircuitadas a tierra, y el diodo del transistor queda en la malla de realimentación, esto hace que no se necesite polarizar, es decir el diodo se comporta como un diodo ideal y la corriente es suministrada a la carga, debido a la configuración colector común.

La especificación de los transistores obedece a la corriente que se le demande a la carga, debido a que queremos obtener máximo 8 [W] en la carga, la corriente máxima que pasará por los colectores de los transistores será de 1 [A], con esto elegimos los transistores tip29 y tip30, que su corriente máxima soportada en el colector son de 1[A].

UNAM, Facultad de Ingeniería 21/10/2017 22:30 Autor: Santiago Cruz Carlos Titulo: Proyecto 1 Mezclador de Audio

PRUEBAS REALIZADAS

1. Las pruebas en tableta fueron satisfactorias, logramos mezclar, un cdwalkman, walkman y la señale del micrófono.

2. Las pruebas en la placa de circuito impreso logramos mezclar la señal de walkman y cdwalkman, teniendo problemas con el control maestro, tal parece por la ganancia lineal que le estamos dando, ya que una región del potenciómetro no se encuentra en perfecto estado y se escucha ruido en la salida.

CONCLUSIONES

- 1. Probamos el circuito mezclador de manera satisfactoria, comprendimos la expresión de la salida en función de las entradas, teniendo un control sobre la salida.
- 2. Experimentamos con dos diferentes configuraciones de potencia, una en la que necesitábamos polarizar los diodos de los transistores, en la cual aun haciendo esto, teníamos una distorsión en la salida; mediante la configuración realimentada, escuchamos un mejor resultado, y el manejo de las señales era prácticamente bueno a partir de los cero volts.
- 3. El prototipo construido experimentamos con los problemas que se llevan para su construcción. Desde la construcción de la fuente, la presentación del gabinete y de los controles para su fácil manejo.

UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos



April 1999 Revised December 2005

LM7805 • LM7806 • LM7808 • LM7809 •

LM7810 • LM7812 • LM7815 • LM7818 • LM7824 •

LM7805A • LM7806A • LM7808A • LM7809A •

LM7810A • LM7812A • LM7815A • LM7818A • LM7824A

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

General Description

The LM78XX series of three terminal positive regulators are available in the TO-220 package and with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Each type employs internal current limiting, thermal shut down and safe operating area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

Features

- Output Current up to 1A
- Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24
- Thermal Overload Protection
- Short Circuit Protection
- Output Transistor Safe Operating Area Protection

Electrical Characteristics (LM7815)

(Refer to the test circuits. -40° C < T $_{J}$ < 125° C, I $_{O}$ = 500mA, V $_{I}$ = 23V, C $_{I}$ = 0.33 μ F, C $_{O}$ = 0.1 μ F, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions		Min	Тур	Max	Unit
Output Voltage	V _o	$T_{,J} = +25^{\circ}C$		14.4	15.0	15.6	v
		$5mA \le l_0 \le 1A, P_0$	j ≤ 15W, V _I = 17.5V to 30V	14.25	15.0	15.75	ı v
Line Regulation	Regine	$T_{,J} = +25^{\circ}C$	V ₁ = 17.5V to 30V	-	11.0	300	
(Note 14)		1	$V_1 = 20V \text{ to } 26V$	-	3.0	150	m∀
Load Regulation	Regload	$T_{,J} = +25^{\circ}C$	I□ = 5mA to 1.5mA	-	12.0	300	m∀
(Note 14)		1	I_{\square} = 250mA to 750mA	-	4.0	150	mv
Quiescent Current	l _Q	$T_{,J} = +25^{\circ}C$	•	-	5.2	8.0	mA
Quiescent Current Change	Δlo	I□ = 5mA to 1A		-	-	0.5	mA
		$V_1 = 17.5V \text{ to } 30V$		-	-	1.0	mA
Output Voltage Drift (Note 15)	ΔV⊘ΔT	I _□ = 5mA		-	-1.0	-	mV/IIC
Output Noise Voltage	V _N	f = 10Hz to 100KH	z, T _A = +25 ^{II} C	-	90.0	-	μV/V _O
Ripple Rejection (Note 15)	RR	f = 120Hz, V _I = 18	.5V to 28.5V	54.0	70.0	-	dВ
Dropout Voltage	VDROP	$I_{\Box} = 1A, T_{J} = +25^{\circ}$	С	-	2.0	-	٧
Output Resistance (Note 15)	rO	f = 1KHz	f = 1KHz		19.0	-	mέΩ
Short Circuit Current	lac	$V_1 = 36V, T_A = +26$	V _I = 36V, T _A = +25 ^a C		250	-	mA
Peak Current (Note 15)	lok	T _J =+26 ^{II} C		-	22	-	Α

Note 14: Load and fine regulation are specified at constant junction temperature. Changes in V₀ due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.

Note 15: These parameters, although guaranteed, are not 100% tested in production.



TIP29 Series(TIP29/29A/29B/29C)

Medium Power Linear Switching Applications

Complementary to TIP30/30A/30B/30C



1.Base 2.Collector 3.Emitter

NPN Epitaxial Silicon Transistor

Absolute Maximum Ratings T_C=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V _{CBO}	Collector-Base Voltage : TIP29	40	V
	:TIP29A	60	V
	:TIP29B	80	V
	:TIP29C	100	V
V _{CEO}	Collector-Emitter Voltage: TIP29	40	V
	:TIP29A	60	V
	:TIP29B	80	V
	:TIP29C	100	V
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage	5	٧
I _C	Collector Current (DC)	1	A
Icp	Collector Current (Pulse)	3	A
I _B	Base Current	0.4	A
Pc	Collector Dissipation (T _C =25°C)	30	W
	Collector Dissipation (T _a =25°C)	2	w
TJ	Junction Temperature	150	°C
T _{STG}	Storage Temperature	- 65 ~ 150	°C

Electrical Characteristics T_C=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Max.	Units		
V _{CEO} (sus)	*Collector-Emitter Sustaining Voltage : TIP29 : TIP29A : TIP29B : TIP29C	I _C = 30mA, I _B = 0	40 60 80 100		V V V		
ICEO	Collector Cut-off Current : TIP29/29A : TIP29B/29C	V _{CE} = 30V, I _B = 0 V _{CE} = 60V, I _B = 0		0.3 0.3	mA mA		
læs	Collector Cut-off Current : TIP29 : TIP29A : TIP29B : TIP29C	V _{CE} = 40V, V _{EB} = 0 V _{CE} = 60V, V _{EB} = 0 V _{CE} = 80V, V _{EB} = 0 V _{CE} = 100V, V _{EB} = 0		200 200 200 200	μΑ μΑ μΑ μΑ		
I _{EBO}	Emitter Cut-off Current	V _{EB} = 5V, I _C = 0		1.0	mA		
hFE	*DC Current Gain	$V_{CE} = 4V, I_{C} = 0.2A$ $V_{CE} = 4V, I_{C} = 1A$	40 15	75			
V _{CE} (sat)	*Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 1A, I _B = 125mA		0.7	V		
V _{BE} (sat)	*Base-Emitter Saturation Voltage	V _{CE} = 4V, I _C = 1A		1.3	V		
f _T Current Gain Bandwidth Product V _{CE} = 10V, I _C = 200mA 3.0 MHz *Pulse Test: PWs300µs, Duty Cycles2%							

62001 Fairchild Semiconductor Corporation

Rev. A1, June 2001



TIP30 Series(TIP30/30A/30B/30C)

Medium Power Linear Switching Applications

Complementary to TIP29/29A/29B/29C



PNP Epitaxial Silicon Transistor

1.Base 2.Collector 3.Emitter

Absolute Maximum Ratings Tc=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V _{CBO}	Collector-Base Voltage : TIP30	- 40	V
	:TIP30A	- 60	V
	:TIP30B	- 80	V
	:TIP30C	- 100	V
VŒO	Collector-Emitter Voltage : TIP30	- 40	V
	:TIP30A	- 60	V
	:TIP30B	- 80	V
	:TIP30C	- 100	V
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage	- 5	V
I _C	Collector Current (DC)	- 1	A
l _{CP}	Collector Current (Pulse)	- 3	A
I _B	Base Current	- 0.4	A
Pc	Collector Dissipation (T _C =25°C)	30	w
Pc	Collector Dissipation (T _a =25°C)	2	W
TJ	Junction Temperature	150	°C
T _{STG}	Storage Temperature	- 65 ~ 150	°C

Electrical Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Max.	Units
V _{CEO} (sus)	* Collector-Emitter Sustaining Voltage : TIP30 : TIP30A	I _C = -30mA, I _B = 0	-40 -60		V V
	: TIP30B : TIP30C		-80 -100		v v
ICEO	Collector Cut-off Current : TIP30/30A : TIP30B/30C	V _{CE} = -30V, I _B = 0 V _{CE} = -60V, I _B = 0		-0.3 -0.3	mA mA
Ices	Collector Cut-off Current : TIP30 : TIP30A : TIP30B : TIP30C	V _{CE} = -40V, V _{EB} = 0 V _{CE} = -60V, V _{EB} = 0 V _{CE} = -80V, V _{EB} = 0 V _{CE} = -100V, V _{EB} = 0		-200 -200 -200 -200	μΑ μΑ μΑ μΑ
I _{EBO}	Emitter Cut-off Current	V _{EB} = -5V, I _C = 0		-1.0	mA
hFE	* DC Current Gain	$V_{CE} = -4V, I_{C} = -0.2A$ $V_{CE} = -4V, I_{C} = -1A$	40 15	75	
V _{CE} (sat)	* Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = -1A, I _B = -125mA	1	-0.7	V
V _{BE} (sat)	* Base-Emitter Saturation Voltage	V _{CE} = -4V, I _C = -1A		-1.3	V
f _T *Pulse Test:PW≤30	Current Gain Bandwidth Product	V _{CE} = -10V, I _C = -200mA	3.0		MHz

*Pulse Test: PW<300µs, Duty Cycles29

92000 Fairchild Semiconductor International

Rev. A, February 2000

Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.
(Note 5)

	LM741A	LM741E	LM741	LM741C
Supply Voltage	±22V	±22V	±22V	±18V
Power Dissipation (Note 1)	500 mW	500 mW	500 mW	500 mW
Differential Input Voltage	±30V	±30V	±30V	±30V
Input Voltage (Note 2)	±15V	±15V	±15V	± 15V
Output Short Circuit Duration	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous
Operating Temperature Range	-55°C to +125°C	0°C to +70°C	-55°C to +125°C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C	-65°C to +150°C
Junction Temperature	150°C	100°C	150°C	100°C
Soldering Information				
N-Package (10 seconds)	260°C	260°C	260°C	260°C
J- or H-Package (10 seconds)	300°C	300°C	300°C	300°C
M-Package				
Vapor Phase (60 seconds)	215°C	215°C	215°C	215°C
Infrared (15 seconds)	215°C	215°C	215°C	215°C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.

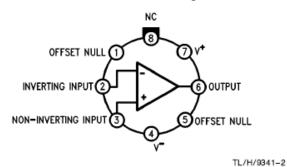
ESD Tolerance (Note 6) 400V 400V 400V 400V

Electrical Characteristics (Note 3)

Parameter	Conditions	LM74	11A/LI	M741E		LM741		l	_M7410	;	Units
Parameter	M		Тур	Max	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Office
Input Offset Voltage	$\begin{aligned} T_{A} &= 25^{\circ}C \\ R_{S} &\leq 10 \text{ k}\Omega \\ R_{S} &\leq 50\Omega \end{aligned}$		0.8	3.0		1.0	5.0		2.0	6.0	mV mV
	$\begin{aligned} & T_{AMIN} \leq T_{A} \leq T_{AMAX} \\ & R_{S} \leq 50\Omega \\ & R_{S} \leq 10 k\Omega \end{aligned}$			4.0			6.0			7.5	mV mV
Average Input Offset Voltage Drift				15							μV/°(
Input Offset Voltage Adjustment Range	$T_A = 25^{\circ}C, V_S = \pm 20V$	±10				±15			±15		mV
Input Offset Current	T _A = 25°C		3.0	30		20	200		20	200	nΑ
	$T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX}$			70		85	500			300	nΑ
Average Input Offset Current Drift				0.5							nA/°C
Input Bias Current	T _A = 25°C		30	80		80	500		80	500	nΑ
	$T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX}$			0.210			1.5			0.8	μΑ
Input Resistance	$T_A = 25^{\circ}C, V_S = \pm 20V$	1.0	6.0		0.3	2.0		0.3	2.0		МΩ
	$T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX},$ $V_S = \pm 20V$	0.5									МΩ
Input Voltage Range	T _A = 25°C							±12	±13		٧
	$T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX}$				±12	±13					٧
Large Signal Voltage Gain	$\begin{array}{l} T_{A} = 25^{\circ} C, R_{L} \geq 2 k\Omega \\ V_{S} = \pm 20V, V_{O} = \pm 15V \\ V_{S} = \pm 15V, V_{O} = \pm 10V \end{array}$	50			50	200		20	200		V/m\ V/m\
	$ \begin{aligned} & T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}, \\ & R_L \geq 2 k\Omega, \\ & V_S = \pm 20V, V_O = \pm 15V \\ & V_S = \pm 15V, V_O = \pm 10V \\ & V_C = \pm 5V, V_O = \pm 2V \end{aligned} $	32 10			25			15			V/m\ V/m\ V/m\

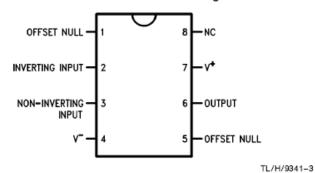
Connection Diagrams

Metal Can Package



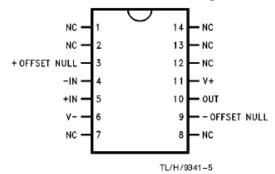
Order Number LM741H, LM741H/883*, LM741AH/883 or LM741CH See NS Package Number H08C

Dual-In-Line or S.O. Package



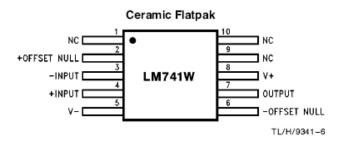
Order Number LM741J, LM741J/883, LM741CM, LM741CN or LM741EN See NS Package Number J08A, M08A or N08E

Ceramic Dual-In-Line Package



Order Number LM741J-14/883*, LM741AJ-14/883** See NS Package Number J14A

^{**}also available per JM38510/10102



Order Number LM741W/883 See NS Package Number W10A

^{*}also available per JM38510/10101

Electrical C	haracteristics	(Note 3) (Co	ontinued)

Parameter	Conditions	LM74	LM741A/LM		LM741		LM741C			Units	
Farameter	Conditions		Тур	Max	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Office
Output Voltage Swing	$V_S = \pm 20V$ $R_L \ge 10 \text{ k}\Omega$ $R_L \ge 2 \text{ k}\Omega$	±16 ±15									V V
	$V_S = \pm 15V$ $R_L \ge 10 \text{ k}\Omega$ $R_L \ge 2 \text{ k}\Omega$				± 12 ± 10	±14 ±13		±12 ±10	±14 ±13		V V
Output Short Circuit Current	$T_A = 25^{\circ}C$ $T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX}$	10 10	25	35 40		25			25		mA mA
Common-Mode Rejection Ratio	$\begin{split} &T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX} \\ &R_S \leq 10 \text{ k}\Omega, V_{CM} = \pm 12V \\ &R_S \leq 50\Omega, V_{CM} = \pm 12V \end{split}$	80	95		70	90		70	90		dB dB
Supply Voltage Rejection Ratio	$\begin{split} &T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}, \\ &V_S = ~\pm 20V \text{ to } V_S = ~\pm 5V \\ &R_S \leq 50\Omega \\ &R_S \leq 10 \text{ k}\Omega \end{split}$	86	96		77	96		77	96		dB dB
Transient Response Rise Time Overshoot	T _A = 25°C, Unity Gain		0.25 6.0	0.8 20		0.3 5			0.3 5		μs %
Bandwidth (Note 4)	$T_A = 25^{\circ}C$	0.437	1.5								MH
Slew Rate	T _A = 25°C, Unity Gain	0.3	0.7			0.5			0.5		V/μ
Supply Current	$T_A = 25^{\circ}C$					1.7	2.8		1.7	2.8	mΑ
Power Consumption	$T_A = 25^{\circ}C$ $V_S = \pm 20V$ $V_S = \pm 15V$		80	150		50	85		50	85	mW mW
LM741A	$V_S = \pm 20V$ $T_A = T_{AMIN}$ $T_A = T_{AMAX}$			165 135							mW mW
LM741E	$V_S = \pm 20V$ $T_A = T_{AMIN}$ $T_A = T_{AMAX}$			150 150							mW mW
LM741	$V_S = \pm 15V$ $T_A = T_{AMIN}$ $T_A = T_{AMAX}$					60 45	100 75				mW mW

Note 1: For operation at elevated temperatures, these devices must be derated based on thermal resistance, and T_j max. (listed under "Absolute Maximum Ratings"). $T_j = T_A + (\theta_{jA} P_D)$.

Thermal Resistance	Cerdip (J)	DIP (N)	HO8 (H)	SO-8 (M)
θ_{jA} (Junction to Ambient)	100°C/W	100°C/W	170°C/W	195°C/W
$\theta_{\rm jC}$ (Junction to Case)	N/A	N/A	25°C/W	N/A

Note 2: For supply voltages less than $\pm\,15\,\text{V}$, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 3: Unless otherwise specified, these specifications apply for $V_S = \pm 15V$, $-55^{\circ}C \le T_A \le +125^{\circ}C$ (LM741/LM741A). For the LM741C/LM741E, these specifications are limited to $0^{\circ}C \le T_A \le +70^{\circ}C$.

Note 4: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/Rise Time(μ s).

Note 5: For military specifications see RETS741X for LM741 and RETS741AX for LM741A.

Note 6: Human body model, 1.5 k $\!\Omega$ in series with 100 pF.

UNAM, Facultad de Ingeniería Autor: Santiago Cruz Carlos	21/10/2017 22:30 Titulo: Proyecto 1 Mezclador de Audio						
BIOGRAFIA:							
PRAT VIÑAS Lluis, <u>Circuitos y dispositivos electrónicos Fundamentos de electrónica</u> Alfaomega 6ª Edición, México DF. http://ieee.udistrital.edu.co/concurso/electronica2/realimentacion.htm							